

反应离子刻蚀 NDR-4000 (M) DRIE深反应离子刻蚀

产品名称	反应离子刻蚀 NDR-4000 (M) DRIE深反应离子刻蚀
公司名称	上海耀他科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那诺-马斯特 型号:NDR-4000 (M) 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室JT4 602 (注册地址)
联系电话	021-62318025 17317363700

产品详情

NDR-4000 (M) DRIE深反应离子刻蚀概述：是带低温晶圆片冷却和偏压样品台的深硅刻蚀系统，带8" ICP源。系统可以配套500L/S抽速的涡轮分子泵，可以使得工艺压力达到几m Torr的水平。在低温刻蚀的技术下，系统可以达到硅片的高深宽比刻蚀。

NDR-4000 (M) DRIE深反应离子刻蚀主要特点：

基于PC控制的紧凑型立柜式百级DRIE深硅刻蚀系统，拥有高纵横比的刻蚀能力；

配套Lab View软件，菜单驱动，自动记录数据；

触摸屏监控；

全自动系统，带安全联锁；

四级权限，带密码保护；

手动上下载片；

He气背面冷却，-60摄氏度的低温样品夹具；

高达-1000V的外部偏压；

涡轮分子泵 + 涡旋干泵；

可以支持DRIE和RIE两种刻蚀模式；

实时显示真空、功率、反射功率图表，以及流量实时显示；

配置内容：

外观尺寸：紧凑型立柜式设计，不锈钢腔体，外观尺寸为44" (W) x 26" (L) x 62" (H)；

等离子源：NM

ICP平面等离子源，带淋浴头气体分布系统。等离子源安装在腔体顶部，通过ISO250的法兰连接；

处理腔体：13" 的圆柱形超净腔体，材质为阳极电镀铝。晶片通过气动顶盖装载，腔体带有上载安全锁，用户可以通过PC控制，至多可以装载8个小尺寸基片，至大可支持的晶圆尺寸为8"。腔体带有2" 的观察窗口。腔体顶部的喷嘴式气流分配装置，提供8" 区域的气体均匀分布。系统带暗区保护。

样品台：6" 的托盘夹具，能够支持6" 的Wafer。可以冷却到-120摄氏度（包含LN2循环水冷系统），并采用He气实现背部冷却和自动锁紧，微精细地控制He气流量，包含气动截止阀；

流量控制：支持5个或更多的MFC's用于硅的深度刻蚀，带气动截止阀，所有的慢/快通道采用电磁阀和气动阀控制，电抛光的不锈钢气体管路带有VCR和VCO(压控振荡器)配件，所有导管以尽可能短的导轨密封设计，从而减低空间浪费并达到快速的气路切换。所有处理气体的管路在处理结束后，采用N2自动冲洗。

真空系统：泵组包含涡轮分子泵和旋叶真空泵。

RF电源：13.56MHz，带自动调谐功能的1000W射频电源，作为ICP源。另外，带自动调谐功能的600W射频电源用于基台偏压。

操作控制：整个系统通过预装的Lab View软件和触摸监控系统，实现PC全自动控制。MFC,阀和顶盖都是气动式的，都可PC控制。系统的实时压力和直流自偏压以图表格式显示，而流量和功率则以字母数字形式显示。系统提供密码和安全连锁机制的四级权限控制。

我公司主要经营各类真空镀膜微纳加工设备，包括薄膜沉积、刻蚀及清洗去胶设备等（ALD，PECVD，RIE，磁控溅射，热蒸镀，电子束，离子束，热真空试验，晶圆清洗机，PA-MOCVD）